证券代码：300567　　证券简称：精测电子　　公告编号：2026-105

武汉精测电子集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到正监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精测电子	股票代码	300567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘炳华	程毅	
电话	027-87671179	027-87671179	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号	
电子信箱	liubinghua@wuhanjingce.com	chengmin@jcelz.cc	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,811,876,512.99	1,381,084,102.09	31.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,034,904.21	27,666,361.74	171.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,406,816.01	-25,441,206.48	219.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-722,707,749.88	-459,636,503.32	-57.23%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.10	170.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.14	157.14%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.76%	0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,228,338,163.82	11,652,662,284.72	13.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,817,912,241.71	4,341,681,456.64	34.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,027		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
彭骞	境内自然人	20.91%	58,500,000	52,584,000	质押	14,835,000
陈需	境内自然人	8.05%	22,529,813	0	不适用	0
武汉文发领域私募基金管理有限公司—文发长江2号私募证券投资基金	其他	5.02%	14,044,100	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	其他	3.44%	9,610,189	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—银华集成电路混合型证券投资基金	其他	3.00%	8,383,965	0	不适用	0
胡剑	境内自然人	2.47%	6,901,108	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.73%	4,850,058	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.68%	4,687,987	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.42%	3,966,500	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	其他	1.06%	2,969,880	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	精测转2	123176	2023年03月02日	2029年03月01日	127,529.13	1.50001

注：001第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	49.87%	55.93%
流动比率	1.62	1.66
速动比率	0.96	1.09
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.24	3.94
EBITDA全部债务比	4.62%	6.54%
利息保障倍数	1.57	2.44
现金利息保障倍数	-15.77	-10.73

三、重要事项

(一)主营业务概况

报告期内，公司主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的研发、生产与销售。凭借成熟可靠的整体解决方案与专业技术服务能力，深度服务于下游半导体晶圆制造厂商、显示面板制造厂商及新能源锂电池生产厂商，为客户提供全方位的量检测设备与技术支持。报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

(二)主要产品及用途

1、半导体量检测领域

公司目前在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、后道电测检测设备、先进封装量检测设备和核心器件等，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动检测设备(ATE)等，用于晶圆加工、制造、封测环节的物理参数测量与电性性能检测，是先进制程良率管控核心装备。

(1)前道量检测领域

产品名称	图示	产品用途
EFILM FD/SS/E/IM Series 薄膜厚度量测设备系列		薄膜量测系列专为先进、成熟半导体制造工艺开发，可精准测量7纳米以下逻辑芯片及高端存储器件中的各类薄膜层参数，全面满足先进制程对薄膜厚度控制的严苛要求。该系列采用激光驱动光源（LDLS）结合先进的光谱甄阐技术，突破性实现纳米级薄膜厚度与光学常数的高精度测量，为工艺优化提供前瞻性数据支撑，显著缩短研发周期并提升量产良率。此外，该系列产品特别支持对高介电金属栅（HKMG）的精确量测，进一步满足先进制程的量测需求。
EPROFILE FD/IM Series 光学关键尺寸量测设备系列		用于三维形貌量测系列专为先进半导体制造工艺开发，可精准表征FinFET器件、三维栅式晶体管结构，以及垂直堆叠NAND闪存、DRAM存储单元等复杂三维结构的形貌参数。该系列产品深度融合光学干涉技术与自主研发的智能建模算法，首创实现纳米级结构的多维度同步解析，可精准监测栅极宽度、侧壁倾角、光刻胶/硬掩模层高等关键工艺参数，其三维形貌重构精度达亚纳米级，对工艺波动敏感度较传统设备提升3倍。
MetaPAM Series 金属膜厚量测设备系列		MetaPAM Series 系统是一款全面的在线金属膜厚计量工具，适用于尖端逻辑、存储器、先进封装和特种半导体器件中的单层和多层金属膜厚测量。创新的光学设计将薄膜厚度测量的动态范围从单个平台上的50A扩展到8μm，小光斑尺寸与快速测量相结合，可实现去边0.5mm的完整晶圆厚度映射功能，还可以测量声速、密度、杨氏模量等多物理量，从而改善工艺开发和优化过程中的信息周转率和信息质量。
SCALE EPI Series 外延层厚度量测设备系列		基于FTIR技术的高精度外延工艺监控方案，SCALE EPI Series集成傅里叶变换红外光谱（FTIR）与先进算法，实现外延层厚度及元素浓度的非破坏性快速检测。系统可对多层外延进行量测，兼容对B、P、C、O等元素浓度进行量测，支持从供应链质量控制（测试晶圆）到量产工艺腔室监控（产品晶圆）的全流程数据闭环，为碳化硅外延、硅基异质集成等前沿工艺提供实时反馈与工艺优化依据。
eMetric Series 电子束关键尺寸量测设备系列		产品具有包括扫描电子显微镜在内的核心零部件的全部自主知识产权。该产品具备百兆赫兹级高速高通量电子束图像采集速度、高速高精度高可靠性的实时自动聚焦能力和多样化功能齐全的量测算法，单点量测时间（MAM）和重复量测精度都达到了国际同类产品的先进水平。超大范围的电子束流和量测视场的调节能力，可满足从微米尺度级到百微米级大视场的截然不同的量测需求。同时，为提高量测速率与工艺设计的高度灵活的智慧型量测点寻址功能（Smart Addressing），可在保证量测点定位精度的同时最大程度地提高设备吞吐量。凭借先进的成像技术和高度自动化的对多层级目标尺寸的在线量测能力，eMetric Series 将为半导体制程提供高效的解决方案。
TG IF/DP/LS/E Series 大硅片几何形貌量测设备系列		用于测量有、无图形晶圆形貌及应力的设备。它通过高精密的光学系统同时获取晶圆正背两面的几何数据，可提供行业内领先的纳米形貌和平坦度检测。
DM Series 离子掺杂浓度量测设备系列		离子注入/退火计量系统能够对一系列半导体技术进行在线注入剂量监测，包括先进设计节点器件和化合物半导体器件。DM Series 可生成有关离子注入剂量和分布、注入和退火均匀性以及晶格损伤等关键过程信息。
eView/eVC eSpec Series 电子束缺陷复检设备		eView Series 电子束（e-beam）晶圆缺陷检查和晶圆分类系统可捕获缺陷的高分辨率图像，从而准确表示晶圆上的缺陷群。采用了新开发的电子光学成像和信号检测技术。它具备快速成像和超高电子束成像能力，低能电子束分辨率低至 1.4 纳米，每小时可采集多达6000 张缺陷图像，适用于先进制程。其独特的多视角成像检测技术和高深宽比特征分析能力，为用户提供了更多的样品信息。它配备了基于深度学习的高精度智能在线自动缺陷识别（ADR）和分类（ADC）算法，API 模式可实现对热点缺陷的自主检测。可选的深紫外暗场模式提高了覆盖圆缺陷的定位精度和检测率。凭借先进的成像技术和强大的分析工具，eView 能够快速、高效、准确地完成缺陷检测、复查和分类，为半导体晶圆制程监控和良率提升提供了有效的解决方案。

产品名称	图示	产品用途
iView /AeroScan Series FIB-SEM分析及 TEM 样品制备系列		AeroScan Series 双束系统，集 SEM 和 FIB 于一体，两者的结合，在保留原有 SEM 超高分辨率和 FIB 优异的微纳加工能力的基础上，可以实现原位的微纳加工。其中，半导体领域为其最主要的应用领域之一，可用于 IC 芯片缺陷分析、修复和 TEM 样品制备。
BFI Series 明场光学缺陷检测设备系列		明场光学缺陷检测设备（BFI，Bright Field Inspection）使用高亮度、宽光谱照明，宽光谱大 NA 物镜成像，延迟积分型（TDI，Time Delay Integration）图像传感器采集图像；通过对图像信号进行数字图像处理以识别和分类有图形晶圆上的缺陷及其特征。明场光学缺陷检测设备能够使用多种波段和多种光学模式对前道工艺制程的有图形晶圆开展检测，以实现不同工艺制程中的缺陷的快速识别与分类，从而指导工艺优化与控制，进而促进良率管理与提升。
VEGA Series 无图形晶圆缺陷检测设备系列		适用于硅研片、二氧化硅、氮化硅、金属薄膜、粗糙镀膜表面等多类无图形晶圆，可检测 8、12 寸晶圆。Vega 缺陷检测设备采用深紫外光源和大数值孔径收集系统，集成暗场正入射、斜入射和明场差分干涉相衬（选配）等多种光学检测手段，提升对划痕、凹坑、颗粒等不同缺陷类型的检测能力。设备结合智能机器学习算法，实现自动缺陷识别与分类，搭载高性能 PMT 探测系统，具备高速数据采集能力，能够对集成电路前道制程、先进封装等企业以及相关设备、材料厂商的生产过程进行质量控制和工艺控测，助推客户提升工艺技术、提高良品率、实现降本增效的目标。
J-Metron 3100/3200 Series 电学特性测试设备系列		J-Metron 3100 Series 是采用电容-电压法测试硅外延层载流子浓度的录接触式晶圆测试设备。J-Metron 3100 Series 可用于测试载流子浓度分布、C-V 特性等电学参数，为前道开发工艺和工艺监测应用提供高度可重复的 CV 和 IV 测量。
J-Metron 5000 Series 晶圆允收测试机系列		J-Metron 5000 Series 是先进的全通道并行晶圆电性能测试设备，可以精确测试电流、电阻、电容等参数，适用于先进制程的晶圆可接受性测试。

(2)半导体后道电测检测领域

产品名称	图示	产品用途
J-Metron 6000 Series 电测机系列		J-Metron 6000 Series 显示驱动芯片自动测试系统用于显示驱动芯片 CP 和 FT 测试环节，属于显示驱动芯片后道测试领域。J-Metron 6000 Series 可以完成显示驱动芯片 DC 参数测试、AC 特性测试及功能完整性验证，确保其品质。
JH5302/JH5400/JH5500/JH5510 BI Test System 存储芯片 BI 测试设备	JH5302 JH5400 JH5500 JH5510	搭载自主研发的老化测试系统，针对 Memory 器件提供长期高低温的测试环境，从而加速模拟器件的长期老化，测试复现常温无法发现的故障现象，目前已经开发 JH5302/JH5400/JH5500/JH5510 等系列成熟产品，满足 NAND FLASH/NOR FLASH/UFS/eMMC/DRAM 等各类存储器件的测试需求。
JH6800 CP Test System 存储芯片 CP 测试设备		针对 Memory Wafer 的 CP 测试，具备对存储器晶圆功能测试和 DC 参数测试，整机测试速率高达 400MHz，核心器件自研可控，可提供从探针卡到整机的一站式解决方案，全方位满足 NOR FLASH/NAND/DRAM 器件的 CP 测试。
JH6820 Micro LED CP 测试系统		JH6820 测试设备具备对晶圆测试和分 BIN 能力，内部有可扩展、大电流 DPS 板卡和高集成度的数字 PE 板卡，支持 4-12 寸 micro LED 晶圆测试，搭配主流 Prober，实现了自动化测试，从而提升测试效率，降低测试成本。同时可以作为小型化的 CP 测试机台，满足半导体显示客户低成本的测试需求。
JH8800 FT Test System 存储芯片 FT 测试设备		主要是针对 UFS/eMMC/NAND 等存储器件的 FT 测试系统，搭载自主研发 DSA 转接板，通过搭配标准 FT Handler 适配高低温，以及自动化上下料等测试场景，支持分 Bin 及高 UPH，提升客户的测试效率。
JH5520 HBM BI 测试设备		JH5520 老化测试系统是针对 HBM 封装老化测试设备，支持高速、宽温度范围、大负载功耗的动态老化测试解决方案。
JH5905A/JH5915A/JH59150A 中高功率老化测试系统	JH5905A JH5915A JH59150A	高性能逻辑芯片老化测试系统主要针对于汽车电子、医疗设备、5G 通信、航空航天、数据中心、AI 智能等关键领域芯片的动态老化测试。系统搭载高效电源系统、多通道高频 IO、高精度控温架构，已经开发出 JH5905A/JH5915A/JH59150A 系列机台，可覆盖从 50W 中低功率到 1000W 以上高功率芯片进行动态老化测试，适用于各类规格逻辑器件的生产筛选、工程特性分析与寿命测试验证，为关键领域芯片的可靠性提升与故障早期筛查提供稳定高效的解决方案。
JHP550/JHP560/JHP580 系列第三代功率半导体可靠性测试系统	JHP550 JHP560 JHP580	针对第三代功率半导体动静态可靠性测试系统及双极性高加速可靠性测试系统，针对碳化硅 MOSFET 的栅极氧化层，通过监测栅极-漏电流的变化，评估器件在高温、高电场条件下的长期稳定性和可靠性，通过大容量、高性能测试（宽电压、高频、高 dv/dt），对缺氢缺陷、界面态劣化、材料缺陷等引发的早期失效进行高效评估与筛选，从而提升器件可靠性和良率。设备集大电流脉冲源、高精度静态参数测量与动态结温控制于一体，系统基于动态高温正向偏压测试原理，通过向被测器件施加重复性的大电流双极脉冲，精准激发并量化体二极管的堆层错扩展导致的性能退化。

(3)先进封装量检测领域

公司现有前道量检测设备(主要包括膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品，具体详见前道量检测设备相关产品情况)已全部导入先进封装产线。

产品名称	图示	产品用途
Dolphin100 & 200 & 300 Series 有图形晶圆缺陷检测设备	Dolphin 100 Dolphin 200 Dolphin 300	专注于 CMOS 图像传感器、AR/VR、Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet 等先进封装工艺的有图形晶圆检测，基于硅基晶圆及玻璃盲埋晶圆工开发 Dolphin100/200/300 系列成熟产品，可针对气泡、溢胶、金属缺失、金属残留、刮伤、变色、RDL 等微小缺陷实现全自动化、高精度智能检测。
SeaGull100 Series 无图形玻璃晶圆缺陷检测设备		应用于裸玻璃、光波导（AR）、玻璃光学镜头、CMOS 等无图形晶圆检测，搭载高度灵活的分辨率探头和双照明系统方案聚焦划伤、点伤、刮伤、崩边、崩角、脏污、Particle 等表面缺陷检测。

(4)核心器件

产品名称	图示	产品用途
WAT 悬臂探针卡		用于各类芯片晶圆流片过程中电性检测。
DDI 悬臂探针卡		用于 LCD/OLED 驱动芯片的 CP 测试。
5830 悬臂探针卡		用于对 NOR、NAND 等存储芯片的 CP 测试。
WST 垂直探针卡		用于 MCU、CPU、GPU、SOC、AI 算力等芯片的 CP 测试。
MLX 垂直探针卡		用于 MCU、CPU,GPU、SOC、AI 算力等芯片的 CP 测试。
2.5D MEMS 探针卡		用于对 NOR、NAND、DRAM 等存储芯片的 CP 测试。

2、平板显示检测设备

公司目前在显示领域的主营产品涵盖LCD、OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED等各类显示器件的检测设备，包括信号检测系统、AOI光学检测系统、OLED调测系统、半导体显示量检测设备、功率测试仪器产品系列、智能和精密光学仪器等，贯穿显示面板研发、生产、老化、修复全制程，保障产线良品率。

产品类型	具体产品	图示	产品用途
信号检测系统	LCD 模组信号检测系统、LCD CELL 信号检测系统、Touch panel 检测系统、LED 点灯检测设备、OLED 模组信号检测系统、OLED CELL 信号检测系统等		信号检测系统可提供多种信号接口并支持通道配置，通过灵活简易的 UI 控制，为显示模组提供信号、图像、高精度电源，驱动模组在被测环境工作，便于快速检查出被测品缺陷。可对显示面板、显示模组的显示效果和电气参数等进行多功能检测，适用于显示面板和模组的研发、生产、信赖性试验等环节的全面测试需求。
AOI 光学检测系统	PI particle 检查机、CF Mura 检查机、框胶检查机、OVI 检查设备、LDCM 检查设备、膜厚检查机、Cell gap 检查机、阻抗/SE 检查设备、Light ON 检查设备、Cell TEST、检查设备、宏观检测机、微观检测机		通过单个或多个高清工业相机、亮色度仪器自动扫描被测品采集图像，运用系统软件进行图形采集识别等处理，识别传测物缺陷并对缺陷进行分类分等，修复 Mura 类缺陷。可针对模组、面板、背光的光学、图像、外观等进行多功能自动检测和量化评价，适用于被测品的产线测试需求。
OLED 调测系统	OLED 模组检测系统、OLED CELL 图形信号检测系统、OLED 光学检测系统、OLED gamma 调测系统、OLED Mura 补偿系统、OLED 寿命检测系统、OLED 光学量化评价系统等		OLED 调测系统为被测品提供视频信号、微安级超高精度电源，便于快速检查出待测物缺陷。可针对 OLED CELL、模组、触控效果的光学特性、电气特性进行多功能检测，整合工业相机及亮色度仪器，可实现亮色度曲线的校正，显示缺陷自动检测，灰度补偿等；适用于产品研发、生产、信赖性试验等完整测试需求。
智能自动化装备	自动物流设备、自动包装设备、自动工艺设备、测试分选设备		智能自动化设备涵盖自动物流、自动包装、自动工艺、测试分选等装备，面向显示面板、半导体等产线，实现物料转运、工艺作业、产品分选、包装全流程自动化作业，与公司量检测设备深度协同，打通检测-分选-流转-包装闭环；助力面板及器件产线提升生产节拍、降低人工介入、保障制程一致性，满足高洁净、高节拍的量产制造需求，赋能产线提质增效。
半导体量检测设备	探针台 ATE 测试设备、探针台 AOI 检测设备、Gamma 校准设备、SLT AOI 检测设备、NED AOI 检测设备		适用于 Micro-LED、Micro-OLED 显示产品的亮度色度与光谱量测调校、缺陷检测及修复，可实现光谱量测与缺陷检测一致性校验、异物分层识别，支持产线快速换线适配等全流程量检测，能够充分满足量产产线在质量控制与生产效率方面的高标准需求，助力 AR/VR、AI 眼镜等近眼显示产品由实验室研发阶段走向终端产业化落地。
功率测试仪器产品系列	直流电源、交流电源、电子负载、脉冲源、电池模拟器		可编程双向高压直流电源兼具供电与反馈负载双重功能，可实现源载模式无缝切换，多电压档位适配宽范围测试场景；可编程直流电子负载采用 ARM+FPGA 高速闭环控制架构，支持 CC/CR/CV/CP、动态负载、短路等多模式测试，内置远端补偿功能，有效降低量测误差。系列产品广泛应用于动力电池、汽车电子、半导体功率器件等领域，覆盖研发验证至量产测试全流程，满足多场景功率测试需求。
光学测试仪器产品系列	成像式亮色度计、光谱仪、光谱增强亮色度计、视角测量仪、色彩分析仪、分光光度计、工业相机		依托色彩科学、高精度成像、智能检测算法、显示颜色测量等核心技术，公司开发光谱仪、色彩分析仪、3D 光学设备、亮色度仪、视角测量仪、近眼显示测量仪等高精密智能化多品类光学测试仪器，面向新型显示、半导体显示、半导体等多领域多场景提供高精度检测解决方案。产品可完成被测物光学特性、颜色管理、Gamma 调测、3D 表面缺陷等全维度量检测，在测量精度、检测效率、设备稳定性等关键指标达到行业先进水平；支持定制化与模块化灵活配置，助力客户保障产品质量、降本增效。

3、新能源检测设备

在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯组装配和检测环节等，包括锂电池切叠一体机、CT&XRAY 无损检测机、化成分容系统、CIR组装配线、锂电池视觉检测系统和BMS检测系统等，保障锂电池生产安全性、一致性与可靠性。

产品类型	具体产品	图示	产品用途
制浆制片段解决方案	切叠一体机		通过恒张力放卷箔极卷裁切成型后，极片配合隔膜进行 Z 形堆叠，保证正、负极片和隔膜之间的相对位置精度，达到设定堆叠层数后，进行尾卷固定和收尾部分裕胶、热压成形、经过绝缘测试及称重测厚检测后输出合格电芯产品。
电池电芯制程段解决方案	离线 CT & XRAY 复合机、化成分容自动产线、电芯六面检测机、包蓝膜机		用于锂电池生产的半在线自动检测、关键制程指标与安全项无损测量管控、化成分容工序、电芯外观缺陷检测、电芯包膜等全流程环节，实现各工序的高精度自动化检测与生产管控。
电池模组制程段解决方案	OCV 检测机、涂胶后保压机 CIR 自动化产线、BMS 测试系统、合盖前电池包 AOI 检测机、模组 PACK 充放电设备		用于锂电池模组/PACK 生产全流程：电芯 OCV 检测、涂胶保压、CTP 集成、BMS 测试、外观品检、充放电性能测试、成品打包及各工序物流转运，实现全流程自动化生产、性能检测与品质管控。

(三)报告期内主营业务分析

报告期内，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域(28nm以下)的研发投入与产品布局，公司明场缺陷检测、无图形晶圆场缺陷检测设备等新产品研发及产业化取得显著进展。伴随产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定；公司新取得头部客户明场缺陷检测14nm工艺节点相关订单，标志着该类产品在先进制程领域的市场应用实现进一步突破，为后续先进制程设备的业务拓展奠定基础。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化量产，交付能力大幅增强。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单相较去年同期实现大幅增长。2026年上半年，国内本土面板厂商依托LCD面板价格上行、行业供需格局修复和高端产品结构升级，加之OLED赛道迈入集中布局建设期，国内企业加紧抢占中尺寸OLED市场份额，面板企业盈利水平普遍回暖。报告期内，公司平板显示检测业务延续快速增长态势，叠加客户结构与产品结构的持续优化，业务毛利率稳中有升，盈利能力维持较强水平。在新能源业务板块方面，报告期内，公司新能源检测板块持续优化产品结构、深化生产精益管控，推动成本稳步下降，营收持续增长，成功实现扭亏为盈，经营基本面持续改善。后续公司将针对性优化调整整体业务结构，集中资源聚焦半导体等核心优势领域，聚力做强主业，进一步提升整体经营效益。

报告期内，公司实现营业收入181,187.65万元，同比增长31.19%；实现归属于上市公司股东的净利润7,503.49万元，同比增长171.21%；报告期末公司总资产为1,322,833.82万元，较期初增长13.52%；归属于上市公司股东的净资产为581,791.22万元，较期初增加34.00%。截至本报告披露日，公司取得在手订单金额总计约55.89亿元，较上年同期增长54.89%；其中，半导体领域在手订单约36.09亿元，较上年同期增长98.00%；显示领域在手订单约12.28亿元，较上年同期减少14.68%；新能源领域在手订单约7.52亿元，较上年同期增长117.22%。半导体领域在手订单占公司在手订单比例已近七成，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

1、半导体量检测业务

(1)前道量检测领域(含半导体量检测业务总括)

当前，半导体产业正逐步进入由AI算力基础设施、先进逻辑芯片、先进封装技术与高端存储器件共同驱动的新一轮上行周期。半导体产业上行周期的发展态势，直接带动了半导体量检测设备销售的增长。报告期内，公司在先进逻辑和先进存储产线中多种关键量检测设备实现规模化交付。

公司所在的半导体前道量检测领域，占半导体总设备市场约13%的第四大设备门类。根据QY-Research的报告显示，2025年全球半导体量检测设备市场销售额达到172.32亿美元，预计到2032年将增长至297.57亿美元，对应2026至2032年间年复合增长率(CAGR)为7.14%。中国市场表现尤为突出，2025年市场规模为55.81亿美元，约占全球的32.39%，预计到2032年将达到103.66亿美元，届时全球占比将提升至34.84%。现阶段，国内半导体量检测领域国产化率较低，市场主要由几家垄断全球市场的国外企业占据主导地位。目前公司是国内半导体量检测设备领域领军企业，逐步形成在半导体检测前道制程、先进封装和后道检测及核心器件的全领域量检测技术产品布局。报告期内，公司半导体领域订单、营收均主要来源于前道量检测领域，前道量检测领域订单、营收占半导体领域整体力成以上，后道检测等领域处于市场导入深化阶段，占公司半导体领域营收和订单的比例较低。报告期内公司在整个半导体板块实现销售收入64,447.33万元，较上年同期增长14.55%；归母净利润4,996.30万元，较上年同期减少31.40%(报告期内，公司进一步增加半导体领域核心资产上海精积微的持股比例，上海精积微现份额于经过了高速投入期，致使归母净利润相较上年同期减少约3,000万元)；公司在半导体领域毛利率为48.75%，较上年同期基本持平。截至本报告披露日，公司在半导体领域在手订单约36.09亿元，较上年同期增长98.00%，半导体领域在手订单占公司在手订单比例已近七成，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

公司半导体量检测业务产品布局情况详见下图：

公司半导体前道量测领域膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，其中膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备等部分主力产品已完成7nm先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在研发中。报告期内，公司应用于先进制程领域(28nm以下，不含28nm)新签订单占半导体领域新签订单超七成，先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，现已成为公司半导体前道量检测领域业绩的核心驱动力。围绕半导体前道量检测业务布局，公司持续推进核心产品的研发与市场落地，相关产品进展如下：

①Efilm系列、IM系列、Scale系列、MetaPAM系列膜厚量测设备

涵盖独立式膜厚量测、集成式膜厚量测、外延层厚度量测和金属膜厚量测设备等系列，应用于逻辑、存储芯片、功率器件、先进封装制造等领域，提供大范围、高精度的膜厚量测方案。最新进展方面，面向先进制程全面迭代，部分产品已完成7nm制程产线的交付和验收，更先进制程相关设备同步研发中。

②Eprofile系列光学关键尺寸OCD量测设备

国内自主研发设计生产并率先量产应用的OCD量测的多功能型独立式光学量测设备，面向IC制造前段先进工艺及更高节点提供OCD量测方案。最新进展方面，面向先进制程全面迭代，部分产品已完成7nm制程产线的交付和验收，更先进制程相关设备同步研发中。

③eView系列电子束缺陷检查设备

基于深度学习的高准确率智能化全自动电子束缺陷检测与分类设备，具有高分辨率复查、高产能、智能缺陷检测及高准确率自动归类等功能、兼容EDX，可对晶圆表面电子束成像及缺陷进行扫描分析。该系列产品已完成7nm制程产线的交付和验收，更先进制程相关设备同步研发中。

④eMetric系列电子束关键尺寸量测设备

利用高分辨率扫描电子显微镜对光阻和刻蚀后图形进行在线式监控量测，满足包括先进制程在内的各类制程工艺的需求，实现高产率，高度自动化，稳定的图形匹配和对齐能力、Die-to-GDS定位、图形缺陷检测、复查、热点分析、显影、刻蚀工艺参数的监控。最新进展方面，产品已完成1Xnm制程产线的交付，面向更先进制程的设备正在研发中。

⑤BFI系列明场光学缺陷检测设备

面向先进逻辑、存储制程的有图形晶圆缺陷检测设备，提供高灵敏度、高分辨率、高检测效率和非破坏性的缺陷检测。最新进展方面，产品已完成28nm制程产线的验收和14nm制程产线的交付；报告期内，公司新取得国内头部客户14nm制程订单，截至本报告披露日，该设备已完成交付，伴随着公司14nm制程订单的再一次交付，产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定，上述进展进一步巩固了公司在明场光学缺陷检测设备领域的领先优势，有利于带动国内该类装备的技术迭代与产业发展。

⑥TG系列硅片形貌量测设备

基于双面Fizeau干涉原理的全尺寸硅片形貌纳米级测量设备，在生产过程中对大硅片质量进行精确、无损监控，用于大硅片制造企业出厂级形貌及厚度检测，已实现批量出货。最新进展方面，产品已完成国内头部大硅片制造企业产线的交付和验收，更高产率、更高性能的下一代产品正在研发中。

⑦FIB-SEM

集合了电子束高分辨表面成像和FIB优异微纳米加工能力，用于晶圆制造过程中线路修补、失效分析、TEM样品制备等，也可应用于纳米器件、微纳米结构等科研领域。最新进展方面，离线式设备已完成客户端的交付和验收；在线式双束设备已交付客户端。

⑧Vega系列无图形暗场缺陷检测设备

面向裸硅片、二氧化硅、氮化硅、金属薄膜、粗糙镀膜表面等多类无图形晶圆检测设备，提供极高速度和高灵敏度的缺陷检测。最新进展方面，面向28nm制程的设备已研发完成，面向更先进制程的下一代产品正在研发中。

⑨WAT

先进的全通道并行晶圆电性测试设备，对完成制程工艺后的晶圆进行晶圆允收测试，精确测试电流、电阻、电容等参数，为晶圆制造排查工艺缺陷、监控参数漂移。该系列产品已完成少量出货。最新进展方面，已完成客户端的交付和验收；面向更先进制程、测试效率更高的下一代产品正在研发中。

(2)后道电测检测领域

公司聚焦ATE领域持续深耕，构建起覆盖先进存储和SOC(系统级芯片)全场景测试体系，为不同领域客户提供定制化、高效可靠的系统测试解决方案。面向先进存储芯片，可提供集成BI(Burn-In)测试、CP(Chip Probing)测试和FT(Final Test)测试于一体的多场景测试方案，全面支持最新的DDR5/LPDDR5/NAND FLASH/UFS等多种存储器芯片。同时针对AI领域的高带宽存储(HBM)，推出JH5520 HBM BI测试系统，精准满足高端存储测试需求。面向系统级芯片，覆盖50W~1000W功率级别的芯片功能、性能及可靠性的测试。相关产品进展如下：

①主要应用于存储领域

BI产品线覆盖了FLASH和DRAM类，目前已适配ONFI 5.0、UFS3.1/UF